



YFD009

产品详细说明

YFW芯片规格书

产品详细说明

YFD009为一氮化镓KU波段高功率放大器,采用0.15umGaN工艺制作。典型指标如下。

频率:12GHz-18GHz;

功率增益:20dB;

饱和输出功率:44dBm;

供电电压:双电源, 负压-1.6V, 正压28V;

功率附加效率:34%。

芯片外形接口如图1所示。

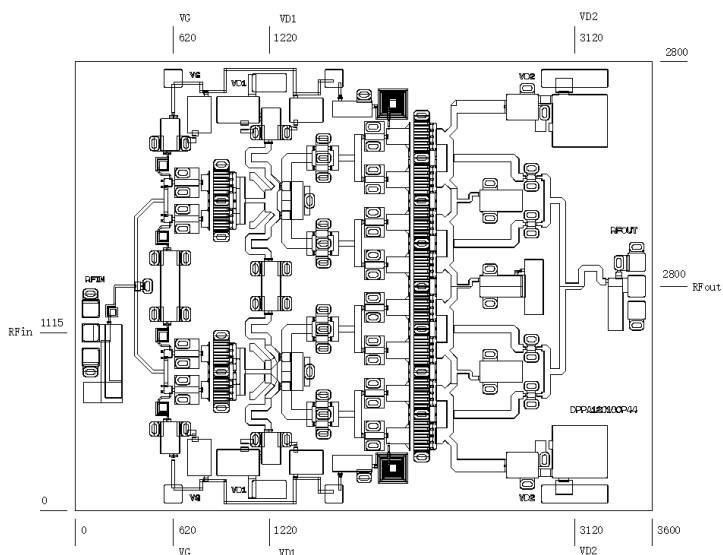


图1 芯片外形接口图

YFD009

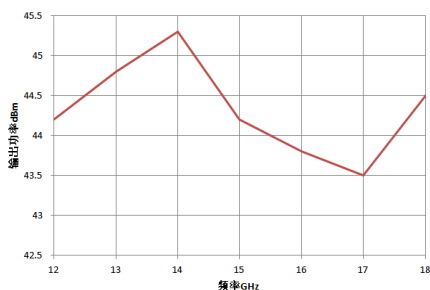
产品详细说明

芯片接口说明如表1所示。

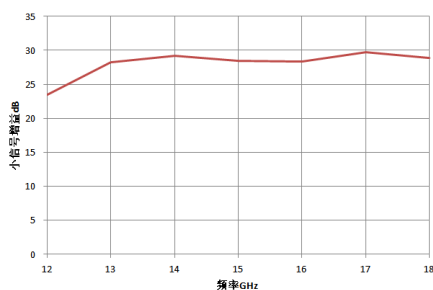
端口名称	端口定义	说明
RFin	射频输入端口	射频输入, 内置隔直电容
RFout	射频输出端口	射频输出, 内置隔直电容
VG	栅极供电端口	电压-1.6V
VD1	漏极供电端口1	电压28V
VD2	漏极供电端口2	电压28V

表1 端口定义

测试结果如图2所示。测试条件: Pin=24dBm, VD1=VD2=28V, VG=-1.6V, 脉宽1ms, 占空比10%, 漏极调制。



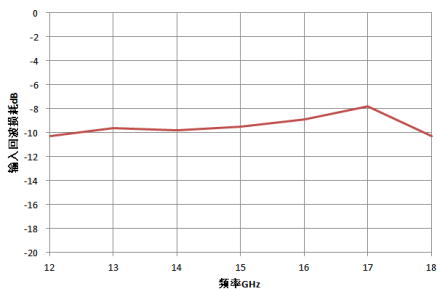
输出功率 (Pin=24dBm)



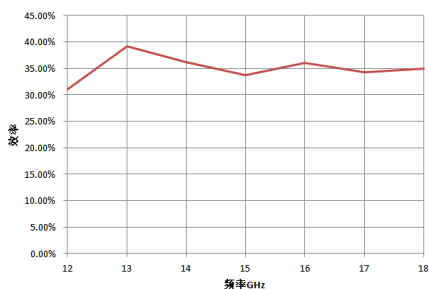
小信号增益

YFD009

产品详细说明



输入回波损耗



效率

装配图如图3所示。

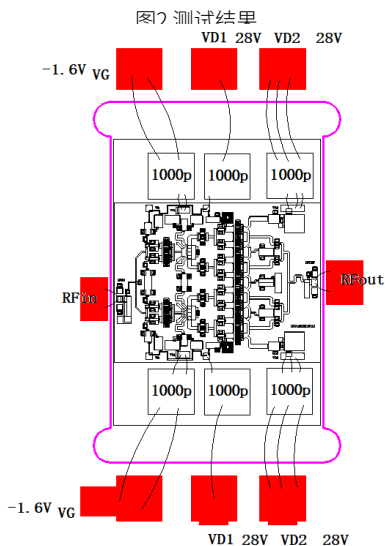


图3 装配示意图

*漏极调制电源需与芯片供电端尽量接近，以10cm之内为宜。